

Silicon Diode

LL4150

600V / 300mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

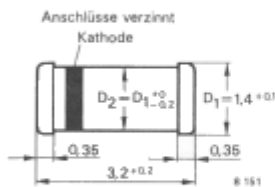
Source: Telefunken Databook 1988

LL 4150

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
MiniMELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzwerte

Periodische Spitzenspannung	U_{RRM}	50	V
Sperrspannung	U_R	50	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1 \mu s$	I_{FSM}	4	A
Durchlaßstrom	I_F	600	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert $U_R = 0$	I_{FAV}	300	mA
Verlustleistung	P_V	500	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 200	°C

Maximale Wärmewiderstände

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
--	------------	-----	-----

LL 4150

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung					
$I_F = 1\text{ mA}$	U_F	0,54		0,62	V
$I_F = 10\text{ mA}$	U_F	0,66		0,74	V
$I_F = 50\text{ mA}$	U_F	0,76		0,86	V
$I_F = 100\text{ mA}$	U_F	0,82		0,92	V
$I_F = 200\text{ mA}$	U_F	0,87		1,0	V
Sperrstrom					
$U_R = 50\text{ V}$	I_R			100	nA
$U_R = 50\text{ V}, T_j = 150\text{ °C}$	I_R			100	μA
Diodenkapazität					
$U_R = 0, f = 1\text{ MHz}, U_{HF} = 50\text{ mV}$	C_D			2,5	pF
Rückwärtserholzeit					
$I_F = I_R = 10 \dots 100\text{ mA}$, $I_R = 0,1 \cdot I_{R1}, R_L = 100\ \Omega$	t_{rr}			4	ns

